DOCY ENT-IDENTIFIER: JP 60161767 A

TITLE:

AUTOMATIC ROTARY COATING MACHINE

PUBN-DATE:

August 23, 1985

#### **INVENTOR-INFORMATION:**

NAME

COUNTRY

KAWASHIMA, SADAMI

### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP N/A

APPL-NO: JP59015561

APPL-DATE: January 31, 1984

INT-CL (IPC): B05C011/08 , H01L021/30

## ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the adhesion of a resist <u>splash</u> to the under surface of an article to be coated, in coating the <u>rotating</u> article to be coated with a coating solution, by providing a <u>mesh</u> to the inner wall of a <u>spinner cup</u> surrounding the periphery of the article to be coated.

CONSTITUTION: The coating of a Si\_wafer 1 is performed by using an automatic rotary coating machine wherein a mesh 15 is provided to the inner wall of the spinner cup 12 mounted to the center part of a wafer chuck 7. In this case, resist splashes 14 are scattered to the inner wall of the cup 12 from the wafer 1 but the reversal of a resist is prevented to prevent the adhesion of the resist splashes 14 to the upper and lower surfaces of the wafer 1. Therefore, when a SiO2-film is etched, the SiO2-film on a surface not coated with the resist is perfectly removed and an impurity diffused layer can be uniformly formed over the entire surface of the water 1 in the SiO2-film removed side in the next impurity diffusion process.

(9日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-161767

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

◎公開 昭和60年(1985)8月23日

B 05 C 11/08 H 01 L 21/30 7248-4F 6603-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

る発明の名称

の出 顧

自動回転盗布機

日本電気株式会社

②特 関 昭59-15561

❷出 顧 昭59(1984)1月31日

⑫ 発明者 川島 貞美

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 菅 野 中

明 細

1.発明の名称

自動回転 強布機

2. 停許請求の範囲

(1) 被盗布物を回転させて該被盗布物に盗布液を 盗布する自動回転盗布機において、前記被盗布物 の周囲を取囲むスピナカップの内壁にメッシュを 設けたことを特徴とする自動回転盗布機。

3.発期の詳細な説明

〔発明の貫する技術分野〕

本発明は自動回転並布根に係わり、とくに強布 液が被塗布物の塗布面と反対の面に付着しないよ りにした自動回転途布機に関するものである。以 下に半導体ウェハーブロセス・フォトレジスト工 程のレジスト途布を例として具体的に述べる。

〔 従来技術〕

半導体はそのウェハープロセスにおいて、Siウェハーの片倒全面にP型あるいはN型不納物を拡散する工程を有し、とれは通常次のように行う。 すなわち、初めにSiウェハー全面に熱度化等によ

り所定厚の SiOs膜を形成する。 次いて Sio エハー の不純物を拡散する側と反対の面金面にレジスト を盆布し、ペーキングの後、ふつ酸系の液でレジ ストの強布されていない側の SiOs膜をエッチング 除去し、さらに適当な方法でレジストを除去する。 その後、とのウェハーを不純物拡散炉に挿入して 所定の拡散を行い、フォトレジスト工程でSiOs膜 の除去された側にのみ不純物を拡散する。とのフ オトレジスト工程の中のレジスト盆布は第1図に 示すような自動造布機を使用して次のように行う。 第1図において、レジスト強布面が上になるよう に Siウエハー 1 を収納したキャリア 2 をローダ部 3 にセットすると、Siウエハー1 がキャリア2中 からスピンコータ部4へゴムベルト5により搬出 される。スピンコータ部4で、トランスフォーム メカニズムアーム 6 (以下 TRM アームと称する) により、 Siウエハー1はウエハーチャンク7上に **報置され、吸着固定される。次いでウエハーチャ** ツク7を回転することにより Siウェハー1を回転 しながら、ウェハーチャック上部に位置するノメ

8から Siウェハー1上 K レジストが所定量 高下され、その後 Siウェハー1 が 所定速度で回転し、レジストが Siウェハー1全面 K 均一 K 塗布される。 塗布後、 Siウェハー1 は TRM アーム 6 K よりウェハーチャック 7 上からゴムベルト 10 K 戦せられ、 次いでゴムベルト 10 K よりアンローダ部 9 のキャリア11 中 K 搬入される。

以上のレジスト盗布において、従来の方法では 次のような欠点を有していた。すなわち、第2図 のようにスピナカップ12内のウェハーチャック7 に Siウェハー 1 をそのレジスト盗布面が上になっ ようにセットし、第3図に示すように Siウェハー 1 が所定速度で回転し、レジスト 13が Siウェハー 1 全面に盗布される際に、 Siウェハー 1 から 所で 変化でする。 Siウェハー 1 から 機切 するレジスト 飛沫14がスピナカップ12 の内 強化 するレジスト 飛沫14がスピナカップ12 の内 強化 でし、一部 Siウェハー 1 の レジスト 強布 面 (Si ウェ ハー1 の上の上が Siウェハー 1 の に 第 4 図のように付着する。 との うち、 Siウェハー 1 下 回のレジスト 飛沫付着部は SiOs 膜がエッチング時

図のように、Siウェハー1のレジスト塗布の際、Siウェハー1からレジスト飛沫14はスピナカップ12の内壁に飛散するが、スピナカップ12の内壁にメッシュ15が設けられているので、レジストははねかえらず、Siウェハー1上、下面へのレジスト飛沫付着はない。したがつて、SiOa膜をエッチングする時、レジストが塗布されていない面のSiOa膜は完全除去され、次の不純物拡散工程でSiウェハーのSiOa膜除去個全面に均一に不純物拡散層を形成することができる。

#### [発明の効果]

以上のように本発明はスピナカップの内壁にメッシュを設けたので、酸メッシュによりレジスト
盗布の際レジストがスピナカップの内壁で衝突して再飛沫するのを防止でき、したがつて余分なレジストがウェハーの上下面に付着することがなくなり、次工程においてウェハーに均一な不納物拡散層を形成することができ、結果として半導体を歩出く製造することができる効果を有するものである。

エッチされずにそのまま残り、したがつて次の不 納物拡散工程において不納物が拡散されないため、 デイバイスとして所期の特性を発揮せず、歩留の 低下を招く。

### 〔発明の目的〕

本発明の目的は従来の欠点を除去した、Siウェ ハー下面にレジスト飛沫付着を起さないレジスト 強布方法を提供することにある。

### (発射の構成)

本名明は被途布物を回転させて段被途布物に途布液を途布する自動回転途布機において、前記被盗布物の周囲を取困むスピナカップの内壁にメッシュを設けたことを特徴とする自動回転盗布機である。

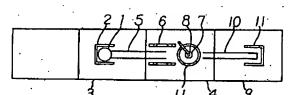
### 〔寒旆例〕

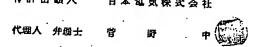
以下、本名明の一実施例を図により説明する。 第5図は本発明の実施例に係わるフォトレジス ト自動途布機スピナカンプ部の略断面図であり、 ウエハーチャンク 7 を中心部分に設置したスピナ カンプ 12の内盤にメンシュ 15 が設けてある。 第6

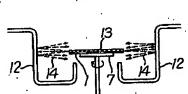
#### 4. 図面の簡単な説明

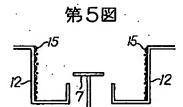
図において、、1 … Siウェハー、2 …キャリア、3 …ローダ部、4 …スピンコータ部、5 …ゴムベルト、6 …トランスフオームメカニズムアーム、7 …ウエハーチャンク、8 … レジストノズル、9

# 特團昭60~161767(3)









# 第4図

